

Инжињеринг енергетског процепа

Поступак добијања полупроводничких легура синтетизовањем полупроводничких једињења да би се добио жељени енергетски процеп(E_g) назива се ИНЖЕЊЕРИНГ енергетског процепа.

E_g је енергија потребна да би електрон прешао са врха валентне на дно проводне зоне.

Основна разлика између GaAs и Si је у врсти E_g што као последицу има и различите примене. GaAs има низ предности као што је виша радна температура (350°C) па се користи за израду ласера и LED. Главни недостатак је што у односу на Si не ствара стабилан оксид.

Препишите у свеску и подсетите се како се деле ел. технички материјали према E_g .

Прицип провођења струје кроз полупроводнике?

Ружица Тодић Брдарић